



前瞻電子元件與材料研究中心

Advanced Electronic Devices and Materials Research Center

標準字 中文 Noto Sans CJK TC 英文 Josi

標準色 ● C25 M40 Y60 同清大Logo標準紫 ● C25 M40 Y60 ● C55 M70 Y100 K20

- 清大電機 前瞻電子元件與材料研究中心 (Center 3F)
Satellite labs:
- 電機系核心設備實驗室 (Lab A-1F)
- 電子所次世代積體電路實驗室 (Lab B-2F)

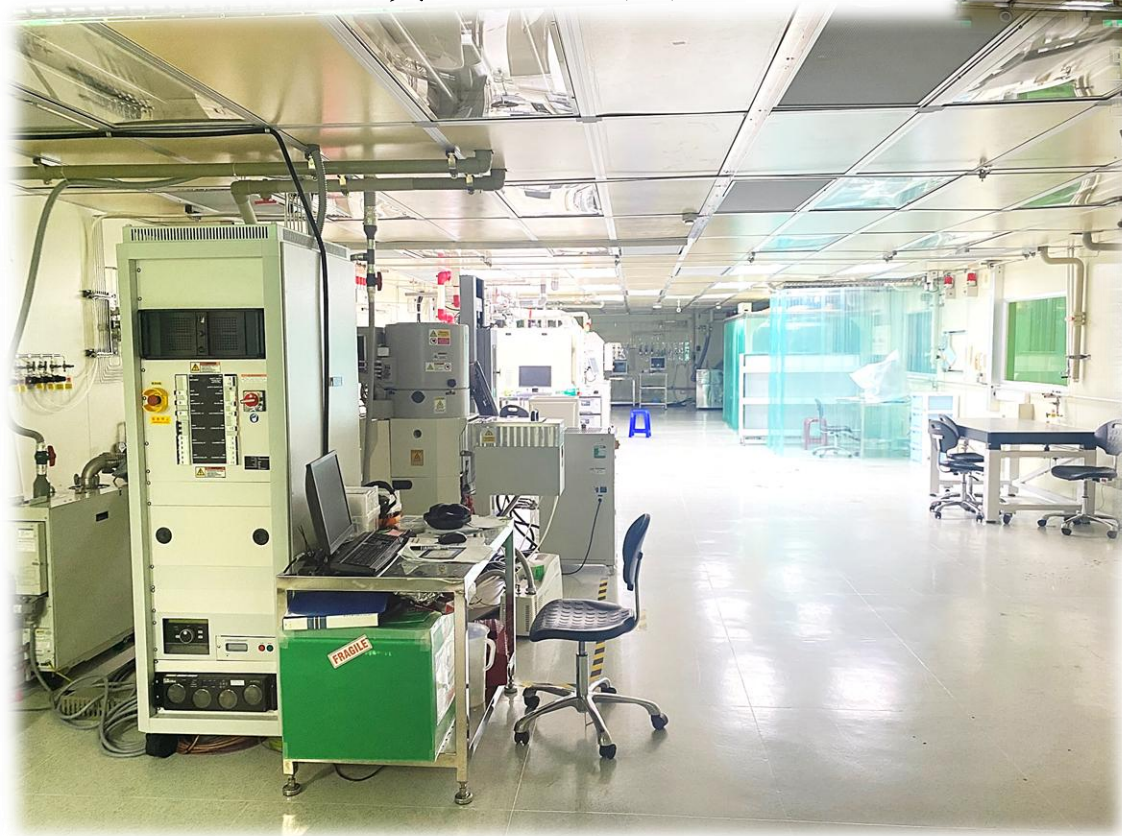
50 電機・再創奇”機”



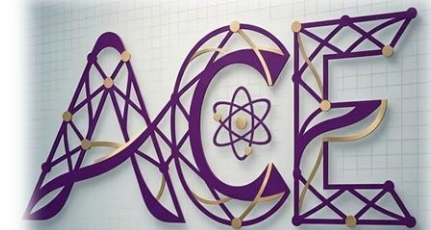
工程三館：無塵室 3F (~85坪) 區域(II)

- 矽光子技術開發
- III-V 化合物半導體
- 低維度半導體晶片開發

實驗區 (I)



EE ACE
EE Advanced Center of Electronic
Devices and Materials



國立清華大學電機系
前瞻電子元件與材料研究中心
EE Advanced Center for Electronic Devices and Materials



工程三館：無塵室 2F (~60坪)

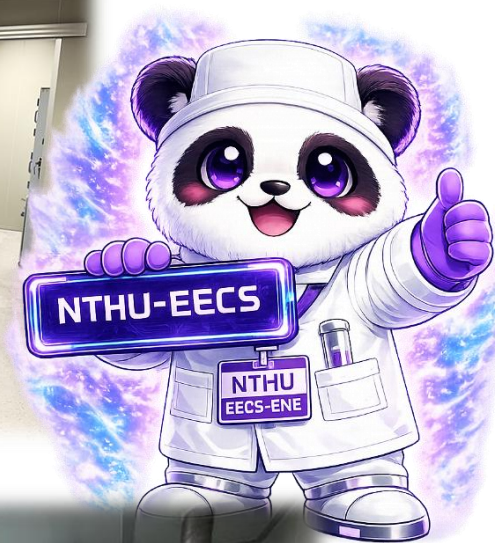
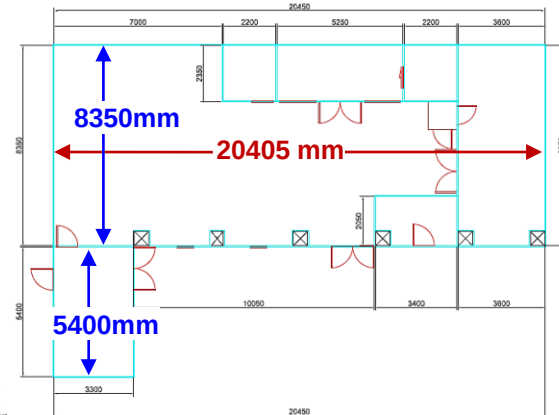
中央實驗區 (I)



中央實驗區 (II)



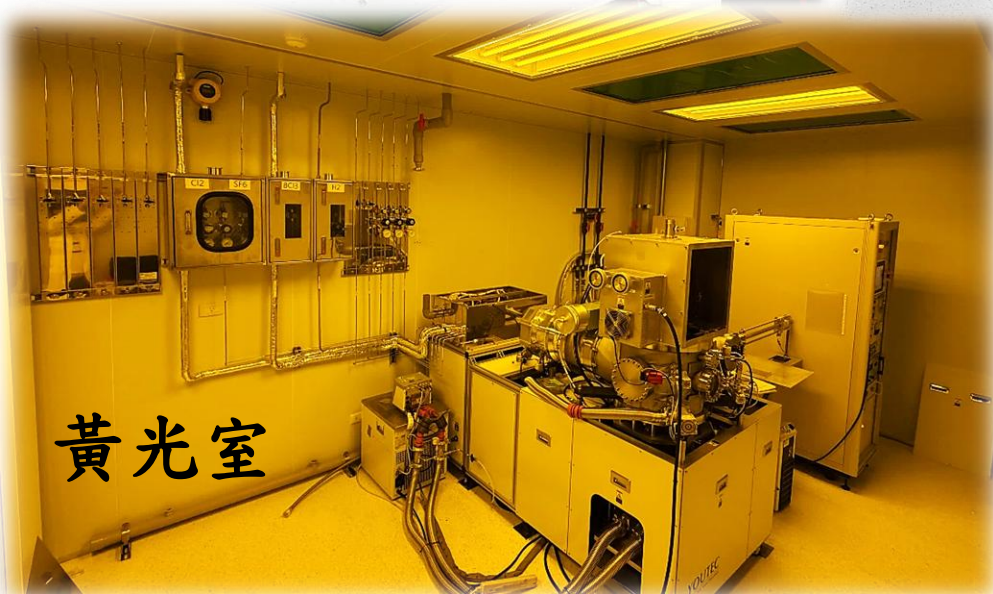
化學槽區



更衣室 (Grooming room) 氣瓶室



黃光室



工程三館：無塵室 1F (~50坪)

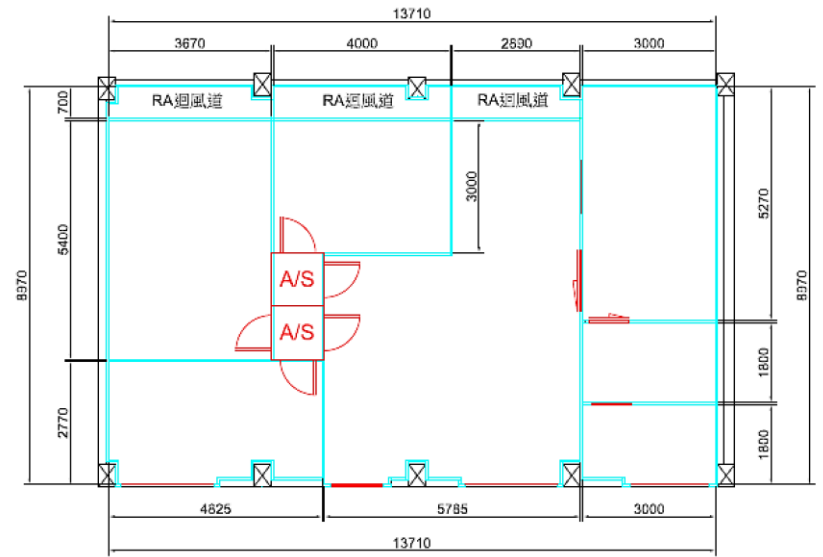
高潔淨區 (up to Class 100)

8970mm

13710 mm

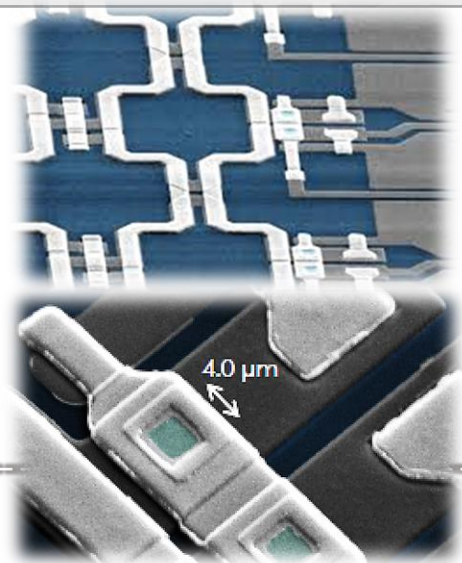
8" Stepper

Lithography tool line-up



Core Facilities – I
(核心設備 I) @ R108

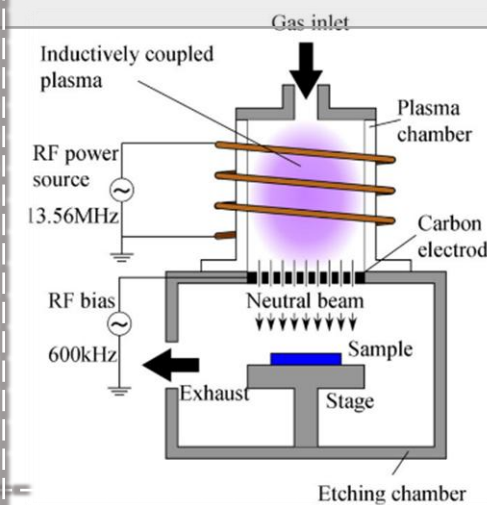
8" Maskless Stepper
(MLA150)
Resolution: 500nm



Minimum Pitch size: 600 nm

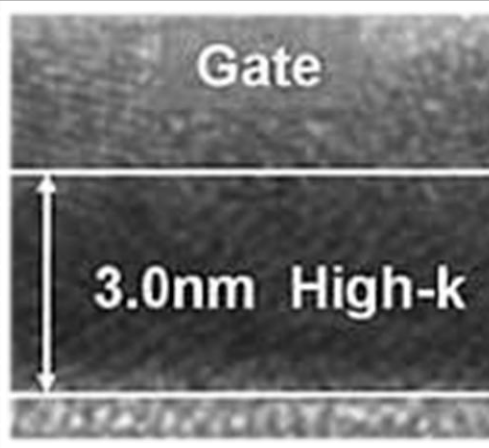
Core Facilities – II
(核心設備 II) @ R212

Neutral-Beam Etcher



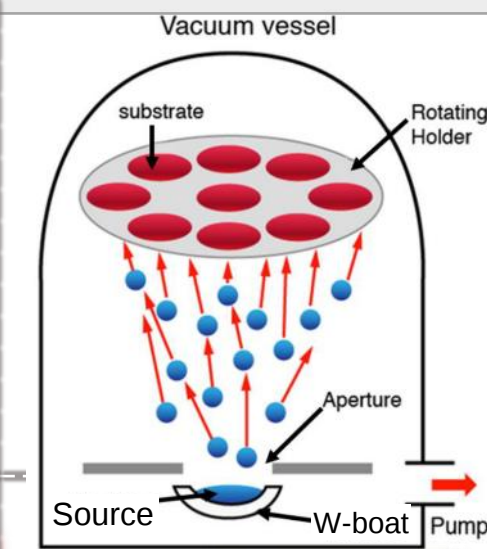
Core Facilities – III
(核心設備 III) @ R212

Atomic Layer
Deposition (ALD)



Core Facilities – IV
(核心設備 IV) @ R212

Thermal Evaporation



Core Facilities – V
(核心設備 V) @ R209

MOCVD Cluster
(M3D-ICs)

